SOT223 NPN SILICON PLANAR MEDIUM POWER TRANSISTOR

FZT657

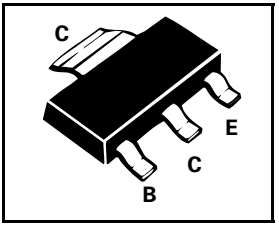
ISSUE 3– FEBRUARY 1995

FEATURES

* Low saturation voltage

COMPLEMENTARY TYPE - FZT757

PARTMARKING DETAIL - FZT657



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	300	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	300	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5	V
Peak Pulse Current	I_{CM}	1	A
Continuous Collector Current	I_C	0.5	A
Power Dissipation at T_{amb}=25°C	P_{tot}	2	W
Operating and Storage Temperature Range	T_j:T_{stg}	-55 to +150	°C

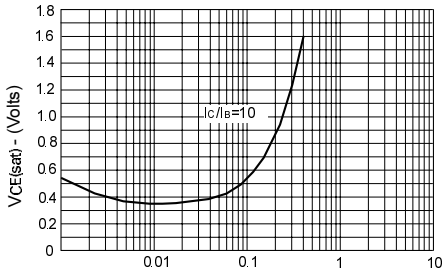
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at T_{amb} = 25°C unless otherwise stated).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	300			V	I_C=100μA
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	300			V	I_C=10mA*
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	5			V	I_E=100μA
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}			0.1	μA	V_{CB}=200V
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}			0.1	μA	V_{EB}=3V
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$			0.5	V	I_C=100mA, I_B=10mA*
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$			1.0	V	I_C=100mA, I_B=10mA*
Base-Emitter Turn-On Voltage	$V_{BE(on)}$			1.0	V	I_C=100mA, V_{CE} =5V*
Static Forward Current Transfer Ratio	h_{FE}	40 50				I_C=10mA, V_{CE} =5V* I_C=100mA, V_{CE} =5V*
Transition Frequency	f_T	30			MHz	I_C=10mA, V_{CE}=20V f=20MHz
Output Capacitance	C_{obo}			20	pF	V_{CB} =20V, f=1MHz

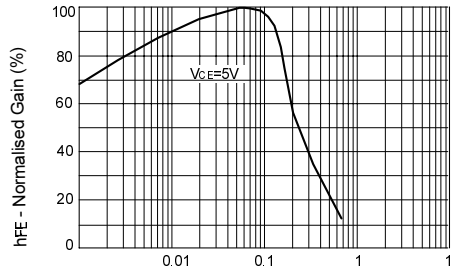
*Measured under pulsed conditions. Pulse Width=300μs. Duty cycle ≤2%
Spice parameter data is available upon request for this device

FZT657

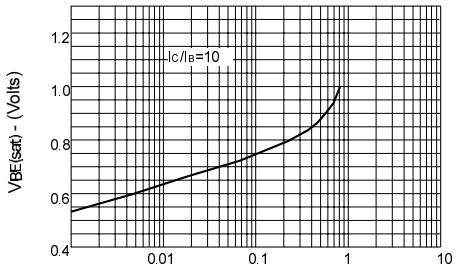
TYPICAL CHARACTERISTICS



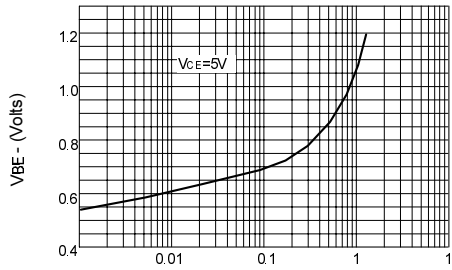
VCE(sat) v IC



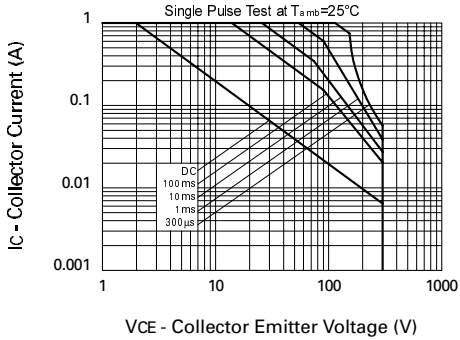
hFE v IC



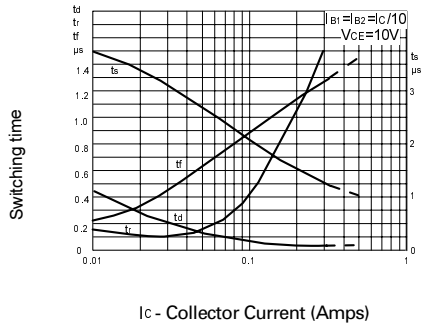
VBE(sat) v IC



VBE(on) v IC



Safe Operating Area



Switching Speeds

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9